

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載

【部門区分】第6部門第4区分

【発行日】平成27年1月22日(2015.1.22)

【公開番号】特開2012-150875(P2012-150875A)

【公開日】平成24年8月9日(2012.8.9)

【年通号数】公開・登録公報2012-031

【出願番号】特願2011-274252(P2011-274252)

【国際特許分類】

G 1 1 C	14/00	(2006.01)
H 0 1 L	29/786	(2006.01)
H 0 1 L	21/8242	(2006.01)
H 0 1 L	27/108	(2006.01)
H 0 1 L	21/8247	(2006.01)
H 0 1 L	27/115	(2006.01)
H 0 1 L	27/10	(2006.01)
H 0 1 L	21/336	(2006.01)
H 0 1 L	29/788	(2006.01)
H 0 1 L	29/792	(2006.01)
G 1 1 C	11/405	(2006.01)
G 1 1 C	11/413	(2006.01)
G 1 1 C	11/412	(2006.01)

【F I】

G 1 1 C	11/34	3 5 2 A
H 0 1 L	29/78	6 1 3 B
H 0 1 L	29/78	6 1 8 B
H 0 1 L	29/78	6 1 8 G
H 0 1 L	27/10	3 2 1
H 0 1 L	27/10	4 3 4
H 0 1 L	27/10	6 2 1 Z
H 0 1 L	27/10	6 5 1
H 0 1 L	27/10	6 7 1 C
H 0 1 L	27/10	6 7 1 Z
H 0 1 L	27/10	4 8 1
H 0 1 L	27/10	4 6 1
H 0 1 L	29/78	3 7 1
G 1 1 C	11/34	3 5 2 B
G 1 1 C	11/34	Z
G 1 1 C	11/40	3 0 1

【手続補正書】

【提出日】平成26年12月2日(2014.12.2)

【手続補正1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】全文

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項1】

制御装置と、演算装置と、緩衝記憶装置とを有し、

前記緩衝記憶装置は、主記憶装置から、或いは前記演算装置から送られてきたデータを、前記制御装置からの命令に従って記憶し、

前記緩衝記憶装置は複数のメモリセルを有し、

前記メモリセルは、チャネル形成領域に酸化物半導体を含むトランジスタと、前記トランジスタを介して前記データの値に従った量の電荷が供給される記憶素子とを有する信号処理回路。

【請求項2】

制御装置と、演算装置と、緩衝記憶装置と、主記憶装置とを有し、

前記緩衝記憶装置は、前記主記憶装置から、或いは前記演算装置から送られてきたデータを、前記制御装置からの命令に従って記憶し、

前記緩衝記憶装置は複数のメモリセルを有し、

前記メモリセルは、チャネル形成領域に酸化物半導体を含むトランジスタと、前記トランジスタを介して前記データの値に従った量の電荷が供給される記憶素子とを有する信号処理回路。

【請求項3】

制御装置と、演算装置と、緩衝記憶装置とを有し、

前記緩衝記憶装置は、主記憶装置から送られてきた命令を含むデータを記憶し、

前記制御装置は、前記緩衝記憶装置から前記データを読み出し、前記命令に従って前記演算装置及び前記緩衝記憶装置の動作を制御し、

前記緩衝記憶装置は複数のメモリセルを有し、

前記メモリセルは、チャネル形成領域に酸化物半導体を含むトランジスタと、前記トランジスタを介して前記データの値に従った量の電荷が供給される記憶素子とを有する信号処理回路。

【請求項4】

制御装置と、演算装置と、緩衝記憶装置と、主記憶装置とを有し、

前記緩衝記憶装置は、前記主記憶装置から送られてきた命令を含むデータを記憶し、

前記制御装置は、前記緩衝記憶装置から前記データを読み出し、前記命令に従って前記演算装置及び前記緩衝記憶装置の動作を制御し、

前記緩衝記憶装置は複数のメモリセルを有し、

前記メモリセルは、チャネル形成領域に酸化物半導体を含むトランジスタと、前記トランジスタを介して前記データの値に従った量の電荷が供給される記憶素子とを有する信号処理回路。